

2SB793, 2SB793A

シリコン PNP エピタキシャルプレーナ形

低周波出力増幅用

2SD973, 2SD973A とコンプリメンタリ

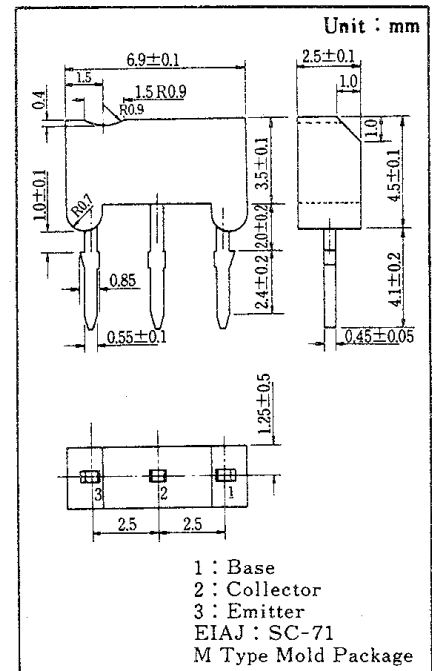
■ 特長

- コレクタ・エミッタ飽和電圧 $V_{CE(sat)}$ が低い。
- M 型パッケージで自動挿入, 手挿入が容易, P 板に自立固定できる。

■ 絶対最大定格 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	-30	V
2SB793A		-60	
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	-25	V
2SB793A		-50	
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	-5	V
せん頭コレクタ電流	I_{CP}	-1.5	A
コレクタ電流	I_C	-1	A
コレクタ損失	P_C^*	1	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

*プリント基板：コレクタ部分の銅箔面積 1cm^2 以上, 厚み 1.7mm



■ 電気的特性 ($T_a=25^\circ\text{C}$)

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタしゃ断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=-20\text{V}, I_E=0$			-0.1	μA
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	$I_C=-10\mu\text{A}, I_E=0$	-30			V
2SB793A			-60			
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	$I_C=-2\text{mA}, I_E=0$	-25			V
2SB793A			-50			
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	$I_E=-10\mu\text{A}, I_C=0$	-5			V
直流電流増幅率	h_{FE1}^{*1}	$V_{CE}=-10\text{V}, I_C=-500\text{mA}^{*2}$	85		340	
	h_{FE2}	$V_{CE}=-5\text{V}, I_C=-1\text{A}^{*2}$	50			
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}, I_B=-50\text{mA}$			-0.4	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=-500\text{mA}, I_B=-50\text{mA}$			-1.2	V
トランジション周波数	f_T	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=50\text{mA}, f=200\text{MHz}$		200		MHz
コレクタ出力容量	C_{ob}	$V_{CB}=-10\text{V}, I_E=0, f=1\text{MHz}$		20	30	pF

*2 パルス測定

*1 h_{FE1} ランク分類

ランク	Q	R	S
h_{FE1}	85~170	120~240	170~340

